

符合BLE 5.0规范的高性能低功耗SOC芯片

主要特性

- 微控制器
 - 32 位高性能 RISC 核心
 - 16MHz/32MHz 时钟
 - 512KB/1MB Flash
 - 40KB 缓存静态 RAM (SRAM)
 - 2 引脚 cJTAG 和 JTAG 调试
 - 支持无线升级 (OTA)
 - 外设
 - 所有数字外设引脚均可连接任意 GPIO
 - 2 个 UART 接口, 硬件支持流控
 - 2 个同步串行接口 (SSI)
 - I2C
 - 2 路 PWM 输出
 - 四个通用定时器模块
 - 实时时钟 (RTC)
 - 键盘控制器
 - 正交解码器
 - AES-128 安全模块
 - 集成电压检测
 - 集成温度传感器
 - 10 位模数转换器(ADC)、1.3MSPS、8 通道模拟多路复用器
 - 支持 16MHz IO 时钟输出
 - 高精度 32KHz RC 振荡器
 - 射频部分
 - 2.4GHz RF 收发器, 符合低功耗
 - BLE5.0 规范
 - -97dBm 接收灵敏度
 - -20dBm ~ +7dBm 的可编程功率
 - 单端 RF 接口
 - 低功耗
 - 工作电压范围: 1.8 至 3.6V
- 
- 芯片内部 DC-DC 转换器
 - MCU 工作电流: 1.4mA @ 16MHz
 - MCU 休眠电流:
 - 0.6uA (IO唤醒)
 - 1.1uA (32KHz on、24K RAM on)
 - 1.0uA (32KHz on、8K RAM on)
 - 接收电流: 8.5mA
 - 发送电流: 9.5mA @ +0dBm
16mA @ +7dBm
- 休眠平均功耗
 - 1s 间隔可连接广播: 24uA
 - 1s 间隔连接保持: 12uA
 - 1s 间隔不可连接广播: 15uA
- 封装
 - 7mm×7mm QFN48 (32 个 GPIO)
 - 4mm×4mm QFN32 (17 个 GPIO)
 - 9.9mm×6.0mm SOP16 (9 个 GPIO)
- 软件特性
 - 集成 Host 和 Controller 协议栈
- 工具和开发环境
 - Keil 编译器
 - JLINK

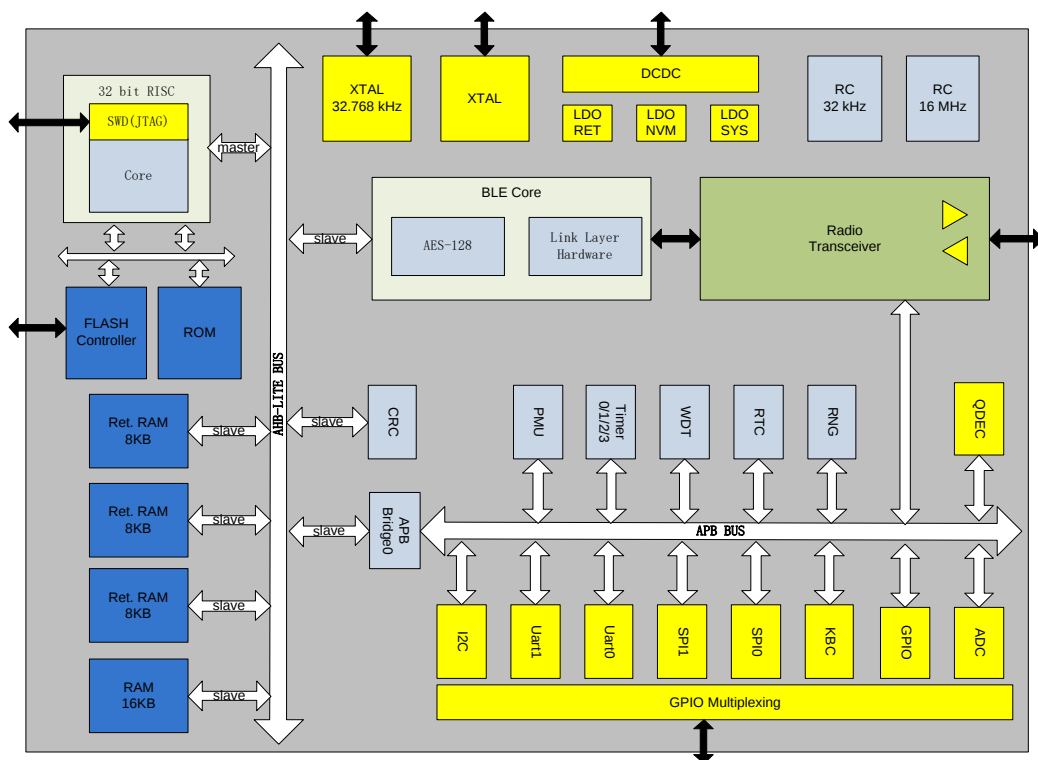
主要应用

- 鼠标键盘
- 无线玩具
- 蓝牙遥控器
- 医疗设备
- Mesh 智能灯
- 工业控制
- 防丢器
- 蓝牙 Key
- 可穿戴设备
- ETC 车载单元

芯片介绍

WS8100是一款符合BLE 5.0规范的高性能低功耗蓝牙SOC芯片。片上集成了Balun，无需阻抗匹配 网络，无需外挂晶振负载电容，无需外部32KHz晶振，最大限度地节省BOM成本。片上集成了高效率 DC-DC降压转换器以实现超低功耗，适合用于高性价比可穿戴、物联网、遥控器、透传、POS、Homekit、 Beacon等低功耗应用。

系统框图



1 管脚描述

1.1 管脚图

WS8100分别采用7x7mmQFN48，4x4mmQFN32，SOP16三种形式封装，管脚定义如下图所示。

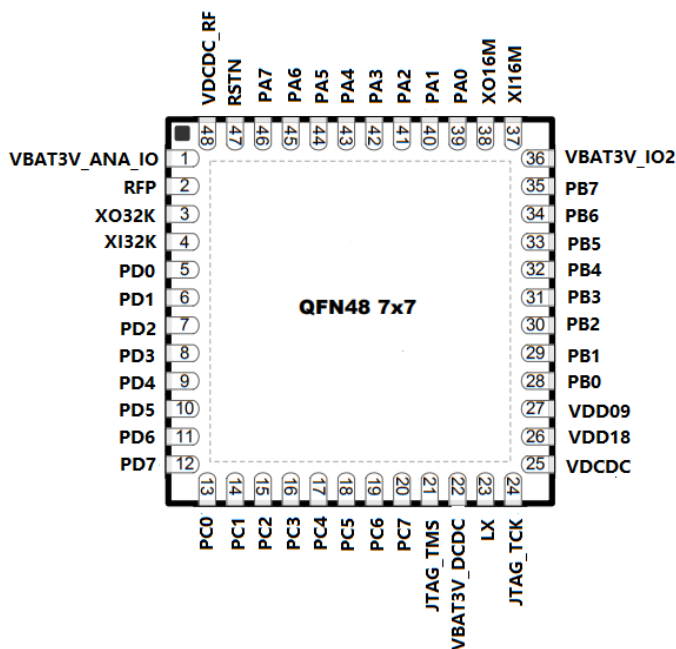


图1 QFN48封装脚位图

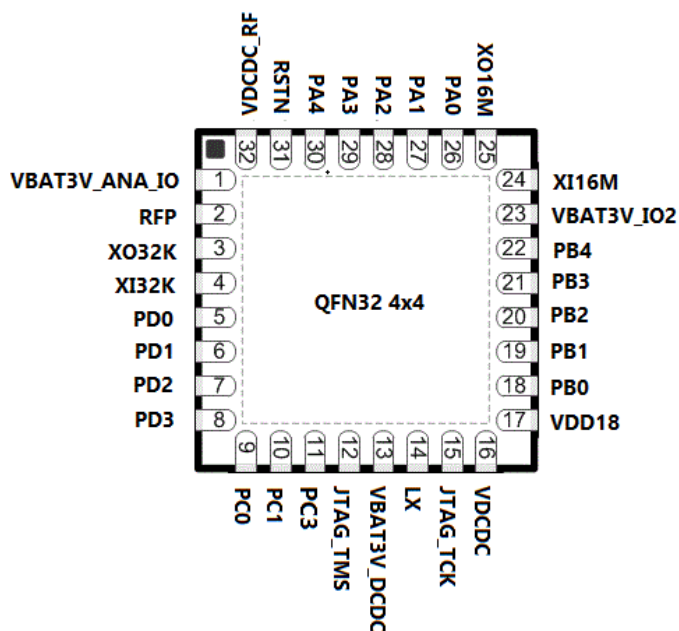


图2 QFN32封装脚位图

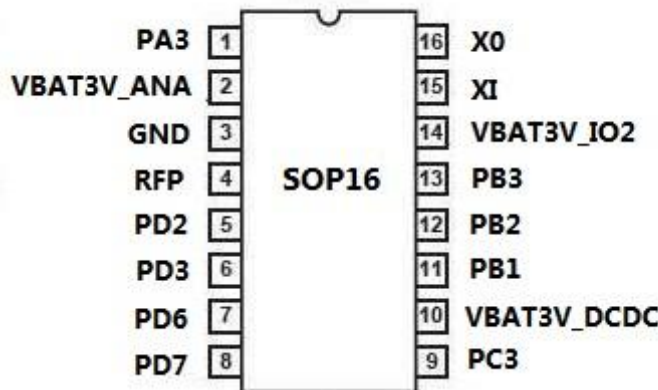


图3 SOP16封装脚位图

1.2 管脚描述

表1 WS8100管脚定义

SOP16	QFN32	QFN48	PIN name	PIN TYPE	PIN DESCRIPTIONS
2	1	1	VBAT3V_ANA_I0	Power	1.8-3.6V电源输入
4	2	2	RFP	Analog pin	射频信号输入/输出
	3	3	X032K	Analog pin	32k晶振输出
	4	4	XI32K	Analog pin	32k晶振输入
	5	5	PD0	Digital I/O	GPIO
	6	6	PD1	Digital I/O	GPIO
5	7	7	PD2	Digital I/O	GPIO
6	8	8	PD3	Digital I/O	GPIO
		9	PD4	Digital I/O	GPIO
		10	PD5	Digital I/O	GPIO
7		11	PD6	Digital I/O	GPIO
8		12	PD7	Digital I/O	GPIO
	9	13	PC0	Digital I/O	GPIO
	10	14	PC1	Digital I/O	GPIO
		15	PC2	Digital I/O	GPIO
9	11	16	PC3	Digital I/O	GPIO
		17	PC4	Digital I/O	GPIO
		18	PC5	Digital I/O	GPIO
		19	PC6	Digital I/O	GPIO
		20	PC7	Digital I/O	GPIO
	12	21	JTAG_TMS	Digital I/O	JTAG
10	13	22	VBAT3V_DCDC	Power	1.8-3.6V电源输入
	14	23	LX	Analog I/O	DCDC输出，外部电感相连
	15	24	JTAG_TCK	Digital I/O	JTAG
	16	25	VDCDC	Power	带DCDC: 1.4V-1.5V电源输入，与内部DCDC输出相连 不带DCDC: 1.8V-3.6V电源输入
	17	26	VDD18	Power	1.8V电源
		27	VDD09	Power	1.2V输出

	18	28	PB0	Digital I/O	GPIO
11	19	29	PB1	Digital I/O	GPIO
12	20	30	PB2	Digital I/O	GPIO
13	21	31	PB3	Digital I/O	GPIO
	22	32	PB4	Digital I/O	GPIO
		33	PB5	Digital I/O	GPIO
		34	PB6	Digital I/O	GPIO
		35	PB7	Digital I/O	GPIO
14	23	36	VBAT3V_I02	Power	1.8-3.6V电源输入
15	24	37	XI16M	Analog pin	16MHz晶振
16	25	38	XO16M	Analog pin	16MHz晶振
	26	39	PA0	Analog&Digital IO	GPIO
	27	40	PA1	Analog&Digital IO	GPIO
	28	41	PA2	Analog&Digital IO	GPIO
1	29	42	PA3	Analog&Digital IO	GPIO
	30	43	PA4	Analog&Digital IO	GPIO
		44	PA5	Analog&Digital IO	GPIO
		45	PA6	Analog&Digital IO	GPIO
		46	PA7	Analog&Digital IO	GPIO
	31	47	RSTN	Digital Pin	外部reset
	32	48	VDCDC_RF	Power	带DCDC: 1.4V-1.5V电源输入, 与内部DCDC 输出相连 不带DCDC: 1.8V-3.6V电源输入
3			GND	GND	GND

2 电气特性

2.1 工作条件

符号	参数	条件	最小	典型	最大	单位
VDD	电源电压		1.8	3.3	3.6	V
TA	工作温度		-40		+105	°C
θ	电源电压斜率		1			mV/ μ s

2.2 极限参数

VDD	稳态电源电压	-0.3 to 3.6	V
Iddpd	关机电流	--	nA
Tamb	工作温度	-40~+105	°C
Tstg	储藏温度	-40~+150	°C
Ground	地	-0.3~0.3	V
Voh	数字输出高电平	VDD -0.3 ~	V
Vol	数字输出低电平	<0.4	V
Ioh	拉电流	15	mA
Iol	灌电流	11	mA
Vih	数字输入高电平	$\geq 0.7 \times VDD$	V
Vil	数字输入低电平	$\leq 0.3 \times VDD$	V

2.3 功耗

工作模式	说明	功耗	单位
RUN	● 所有外设全关		mA
	■ @16MHz	1.4	
	■ @32MHz	2.2	
	● 所有外设全开		
	■ @16MHz	1.6	
	■ @32MHz	2.2	
CPU Sleep	● 开启高速时钟，所有外设全关		mA
	■ @16MHz	1.0	

	■ @32MHz	1.2	
Sleep	● 关闭高速时钟	550	uA
Deep Sleep (常用模式)	关闭高速时钟、关闭外设（支持IO、RTC、KeyBoard、BLE唤醒） ● 内部 32K RC		uA
	■ 8K ram retention	1.0	
	■ 16K ram retention	1.1	
	■ 24K ram retention	1.1	
	● 外部 32K 晶振		
	■ 8K ram retention	1.2	
	■ 16K ram retention	1.3	
	■ 24K ram retention	1.3	
Deep Sleep+	● 关闭高速时钟、关闭外设、RAM 掉电（支持 IO、RTC、KeyBoard 唤醒）	0.9	uA
ShutDown	● 关断状态	50	nA

2.4 晶体振荡器规格

2.4.1 16/32M高速晶振

名称	参数	最小	典型	最大	单位
频率		16	-	32	Mhz
频率精度	@-40 to +85℃	±10		±30	ppm
温度范围		-40		+105	degree
驱动能力			100		uW
ESR	等效串联电阻	40		85	Ω
Cload	负载电容	8	15	20	pF
Cshut	寄生并联电容		5		pF

2.4.2 32K低速晶振

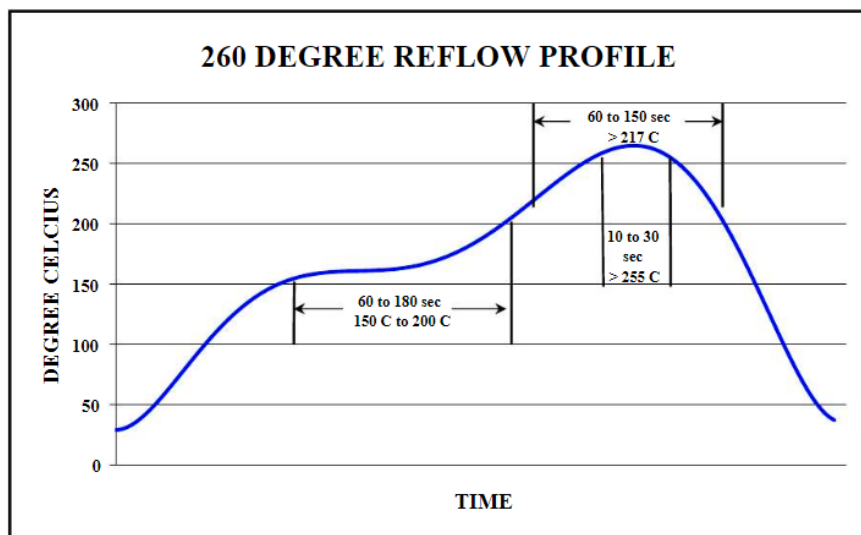
名称	参数 (Condition)	最小	典型	最大	单位
----	-------------------	----	----	----	----

频率			32		KHz
精度		±10		±30	ppm

2.4.3 内部低速RC

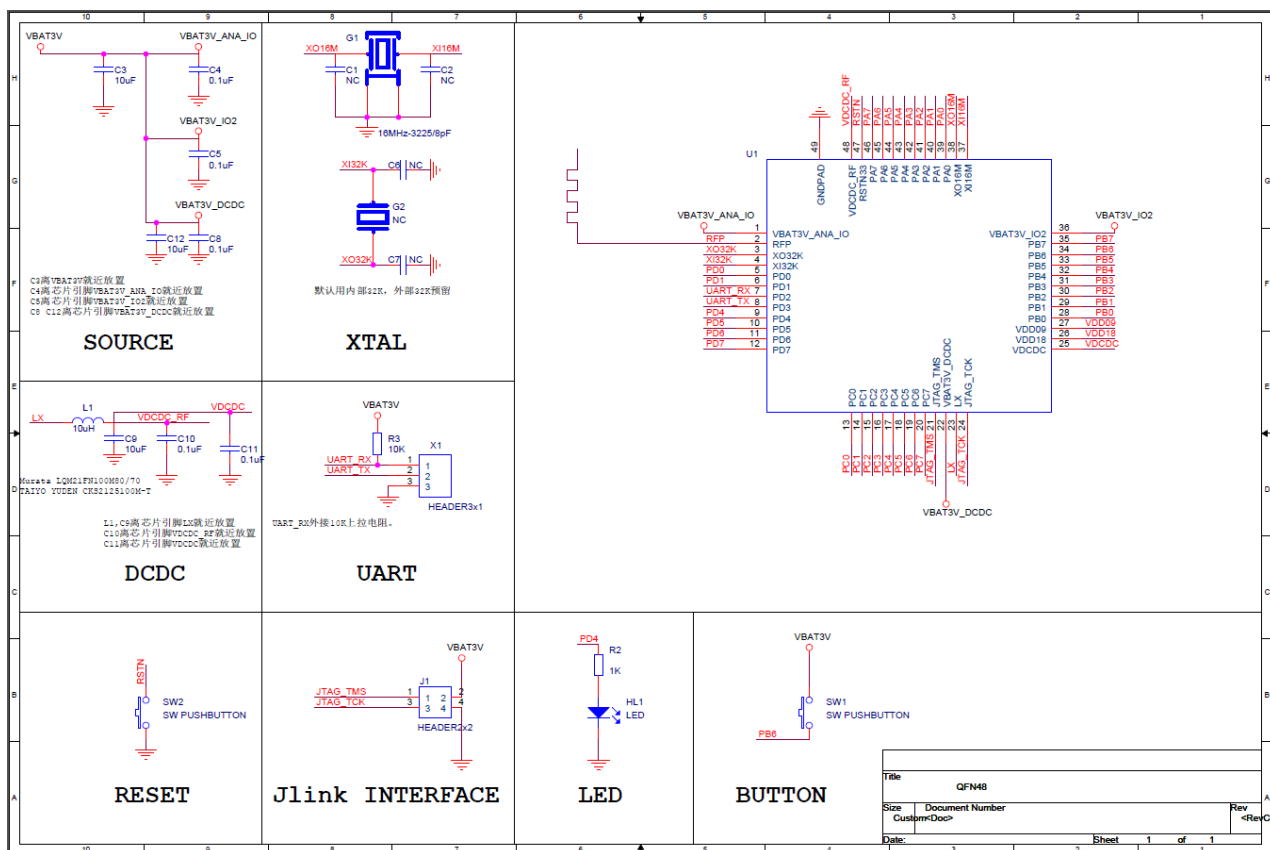
名称	参数 (Condition)	最小	典型	最大	单位
频率			32		KHz
精度				±300	ppm

2.5 回流焊曲线

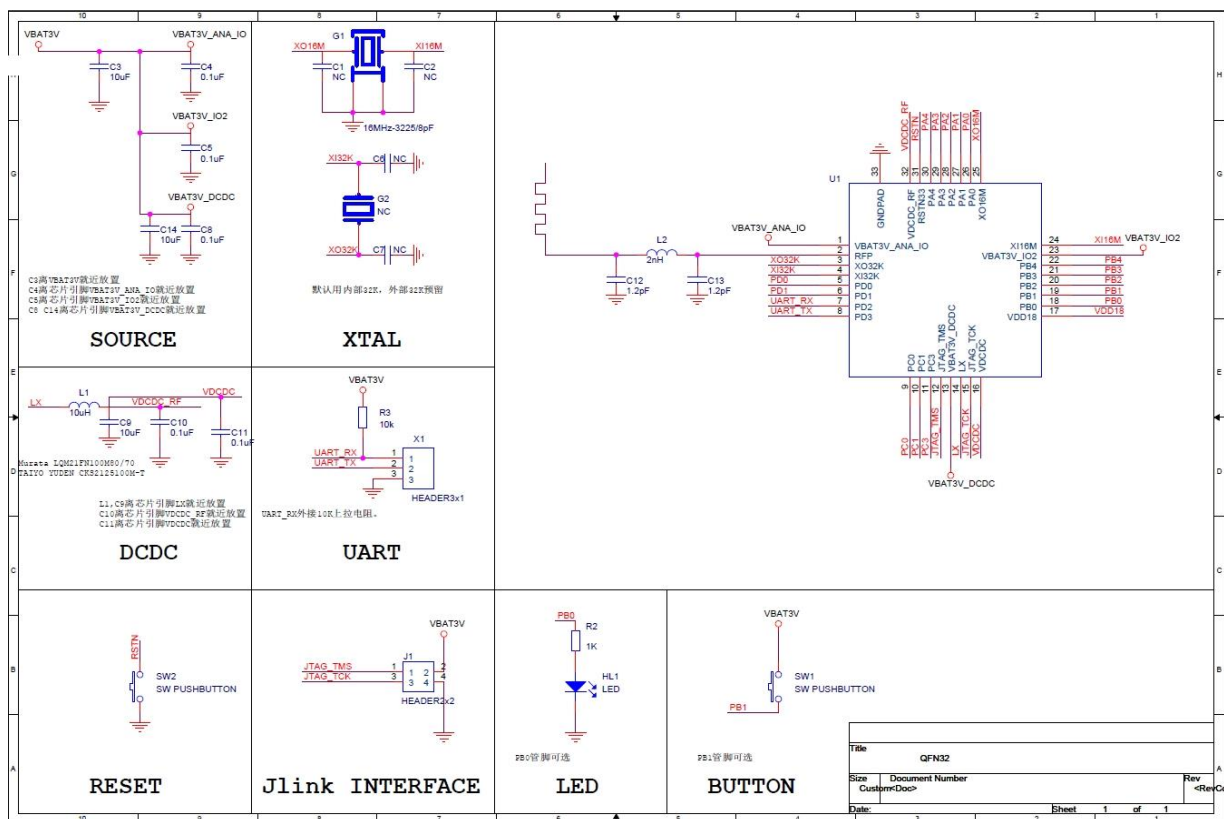


3 电路参考设计图

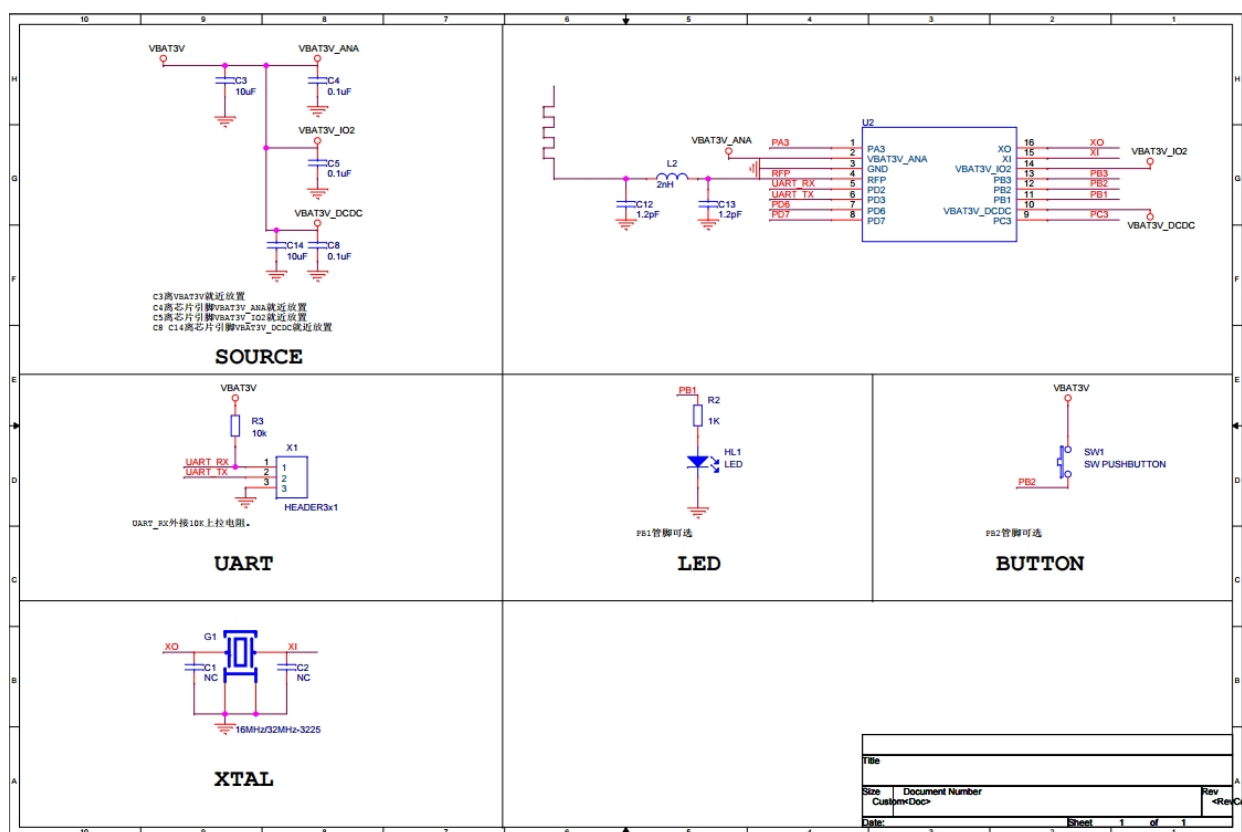
3.1 QFN48原理图设计



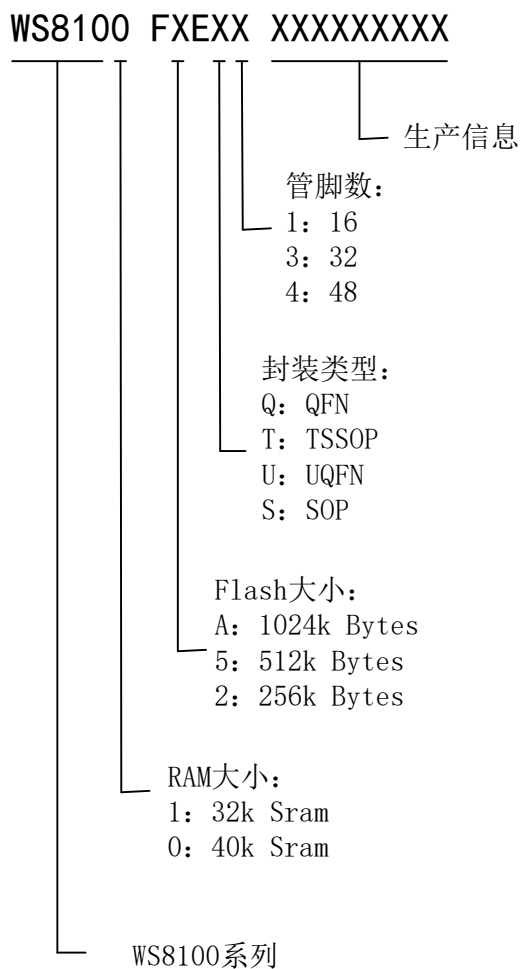
3.2 QFN32原理图设计



3.3 SOP16原理图



4 命名规则

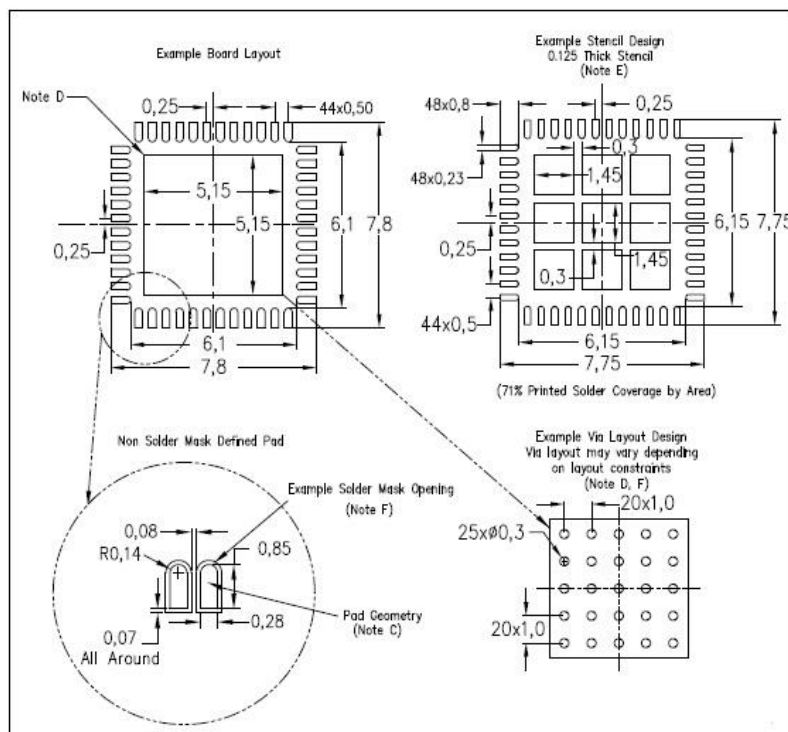
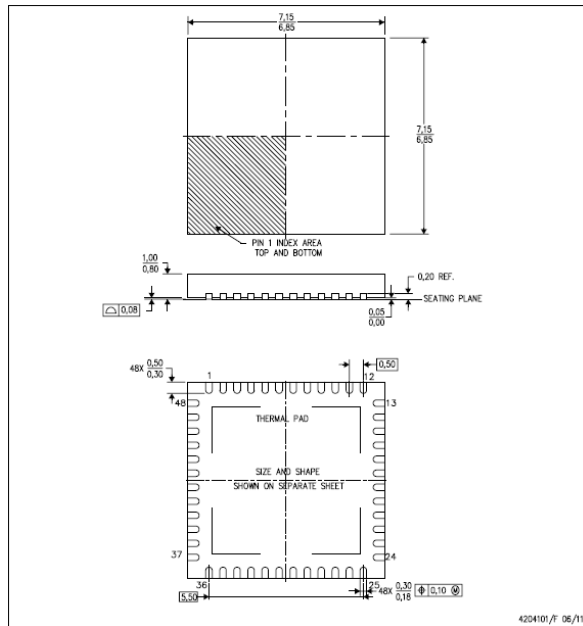


订货信息

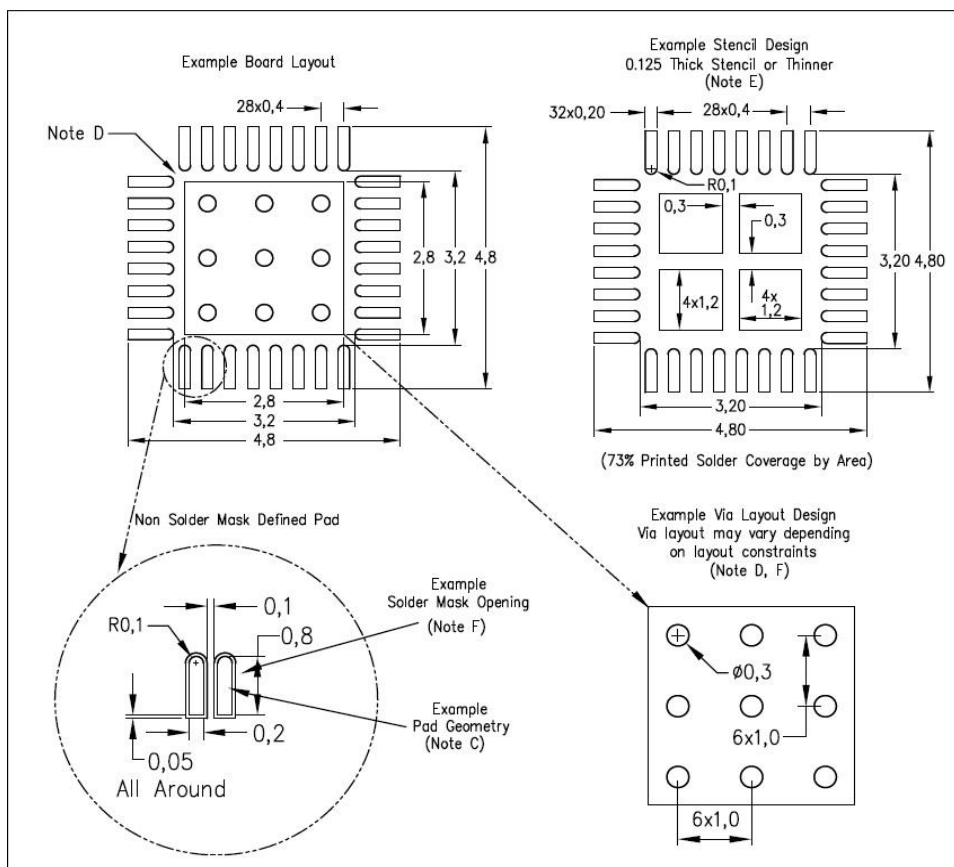
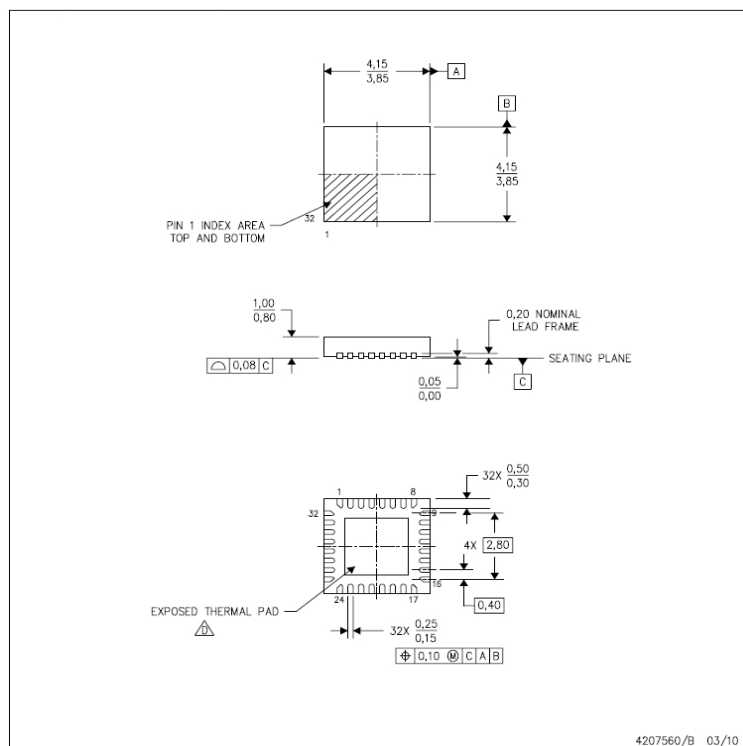
WS8100系列型号	Sram btyes	Flash btyes	封装
WS8100F5ES1	40K	512K	SOP16
WS8100F5EQ3	40K	512K	QFN32
WS8100F5EQ4	40K	512K	QFN48

5 封装

5.1 QFN48封装信息



5.2 QFN32封装信息



5.3 SOP16封装信息

